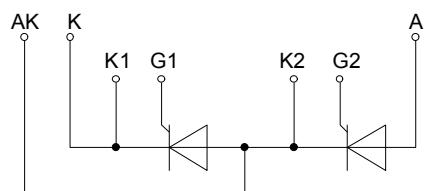
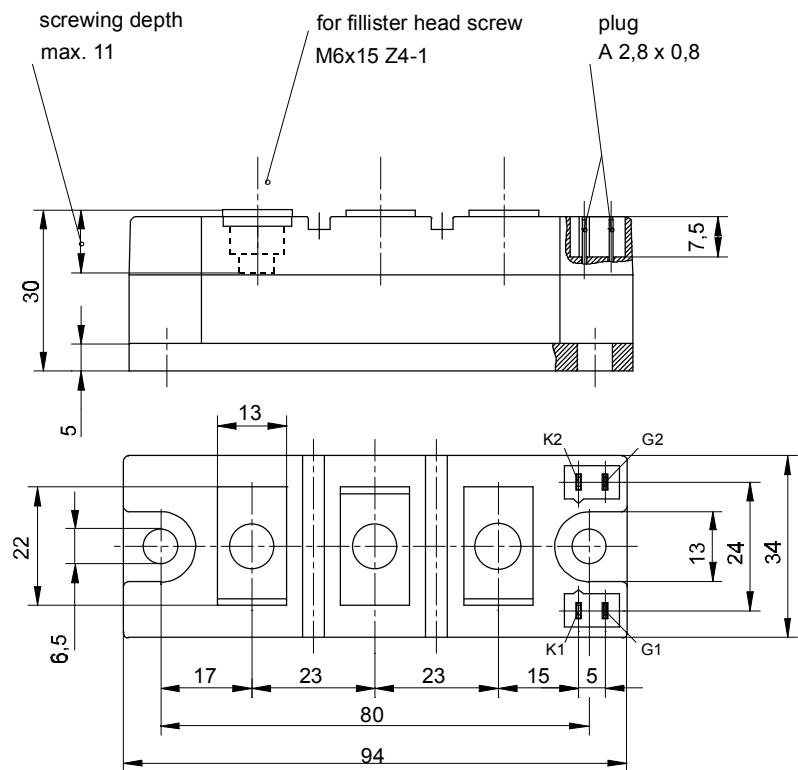




European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information TT 142 N



TT 142 N, TD 142 N, DT 142 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties			
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>			
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$		V_{DRM}, V_{RRM}	600 800 1000 1200 1400 V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$		$V_{DSM} = V_{DRM}$	V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$		$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current			I_{TRMSM}	230 A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$		I_{TAVM}	142 A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$		I_{TSM}	4800 A 4100 A
Grenzlastintegral	$\int i^2 t \text{ value}$	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$		$\int i^2 dt$	115000 A ² s 84000 A ² s
Kritische Stromteilheit	current	$V_D \leq 67\%, V_{DRM}, f_o = 50\text{ Hz}$ $v_L = 10V, i_{GM} = 0,6A, di_G/dt = 0,6A/\mu\text{s}$		$(di/dt)_{cr}$	150 A/ μ s
Kritische Spannungsteilheit	voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$		$(dv/dt)_{cr}$	1000 V/ μ s
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>			
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 500\text{ A}$		V_T	max.1,56 V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$		$V_{T(TO)}$	0,9 V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$		r_T	1,1 m Ω
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\text{ V}$		I_{GT}	max. 150 mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\text{ V}$		V_{GT}	max.1,4 V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\text{ V}$		I_{GD}	max.10 mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$		V_{GD}	max.0,25 V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_A = 5\ \Omega$		I_H	max. 200 mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_{GK} > 10\ \Omega$ $i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$		I_L	max.800 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$		i_D, i_R	max. 30 mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj}=25^\circ\text{C}, i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$		t_{gd}	max.3 μ s
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn.Er./see Techn.Inf.		t_q	typ.200 μ s
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min		V_{ISOL}	2,5 kV
Thermische Eigenschaften		Thermal properties			
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^\circ\text{el,sinus: pro Modul/per module}$ pro Zweig/per arm DC:pro Modul/per module		R_{thJC}	max.0,110 °C/W max.0,220 °C/W max.0,106 °C/W max.0,212 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	heatsink	pro Zweig/per arm pro Modul/per module pro Zweig/per arm		R_{thCK}	max.0,03 °C/W max.0,06 °C/W
Höchstzul.Sperrschihttemperatur	max. junction temperature			$t_{vj\ max}$	125 °C
Betriebstemperatur	operating temperature			$t_{c\ op}$	-40...+125 °C
Lagertemperatur	storage temperature			t_{stg}	-40...+130 °C
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties			
Gehäuse, siehe Seite	case, see page				1
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation	internal insulation				
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		A1N 6 Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2		6 Nm
Gewicht	weight			G	typ.310 g
Kriechstrecke	creepage distance				15 mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz			5 . 9,81 m/s ²

Diese Module können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

These modules can also be supplied with common anode or common cathode.

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

TT 142 N

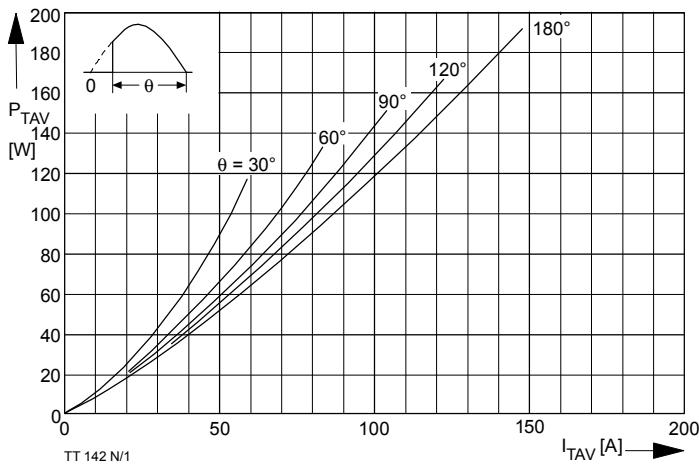


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

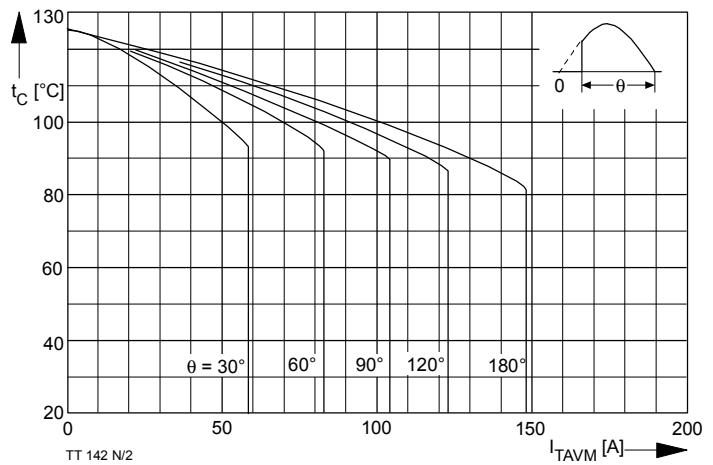


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

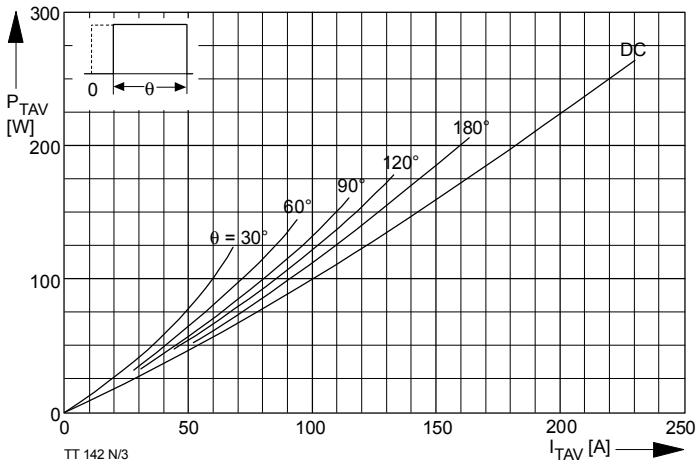


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

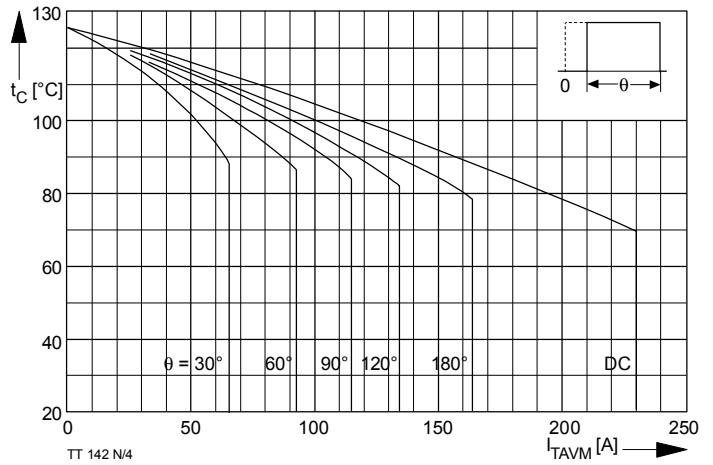


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

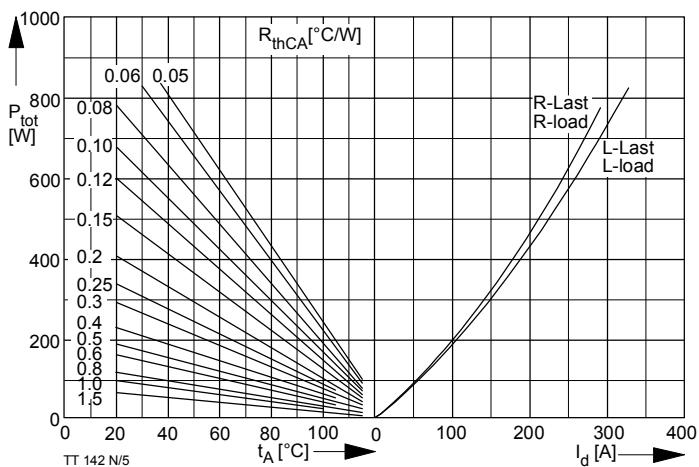


Bild / Fig. 5

B2 - Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

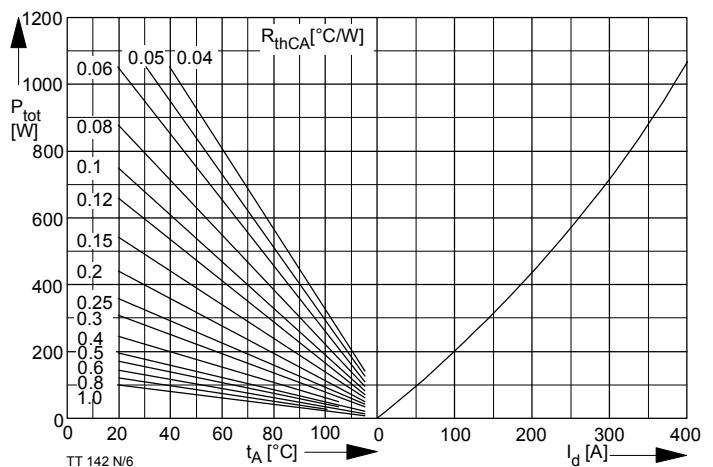


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

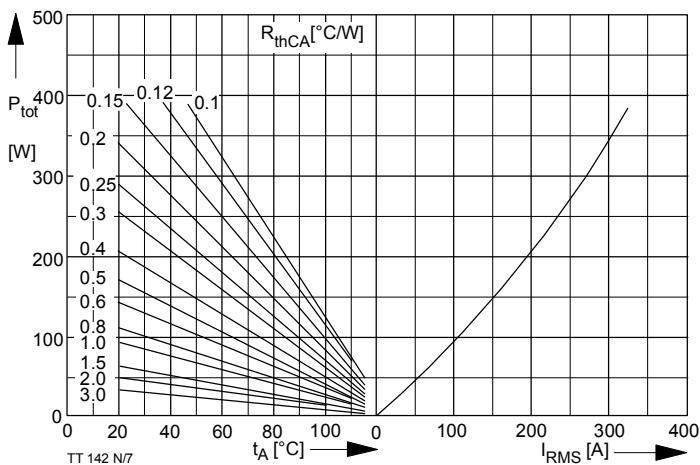


Bild / Fig. 7
W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the
circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

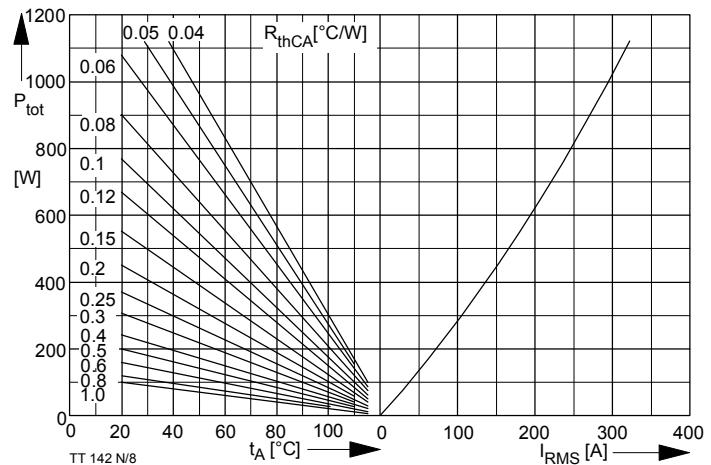


Bild / Fig. 8
W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per
phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

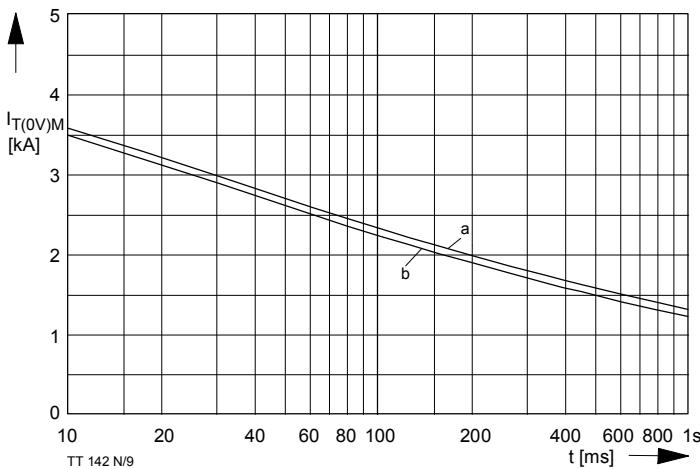


Bild / Fig. 9
Grenzstrom je Zweig $I_{T(\text{OV})M}$: Belastung aus Leerlauf, $V_{\text{RM}} = 0.8 V_{\text{RRM}}$
Maximum overload on-state per arm current $I_{T(\text{OV})M}$: Surge current under
no-load conditions, $V_R = 0.8 V_{\text{RRM}}$
a - $t_A = 35^{\circ}\text{C}$, verstärkte Luftkühlung / forced cooling
b - $t_A = 45^{\circ}\text{C}$, Luftseltbstkühlung / natural cooling

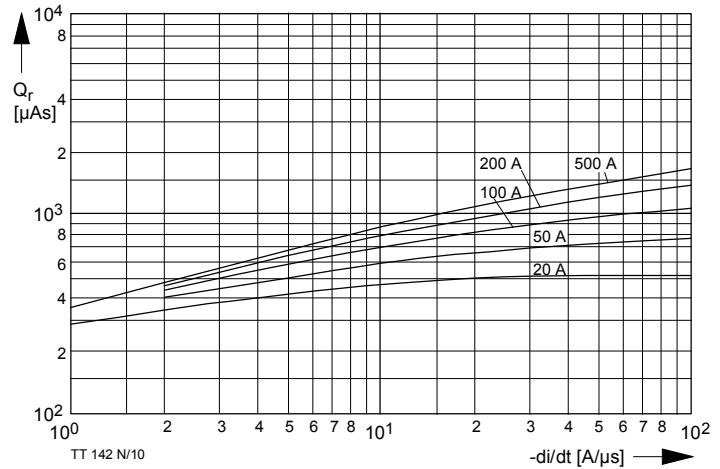


Bild / Fig. 10
Sperrverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vmax}$, $V_R \leq 0.5 V_{\text{RRM}}$, $V_{\text{RM}} = 0.8 V_{\text{RRM}}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

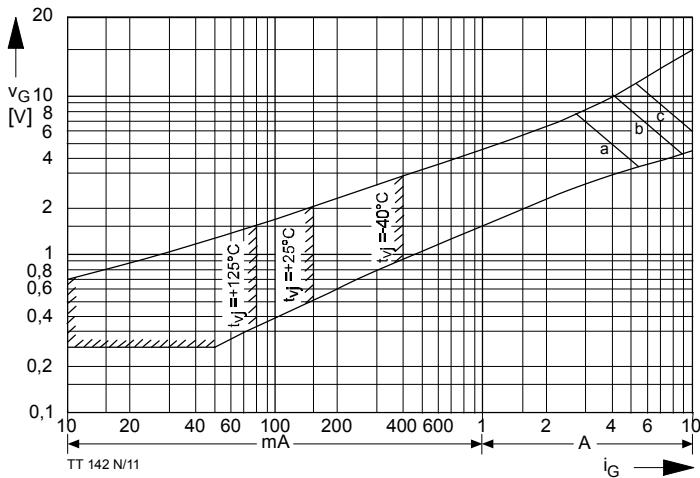


Bild / Fig. 11
Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering
areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 \text{ V}$
Parameter:
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t_g [ms] 10 1 0,5
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 20 40 60

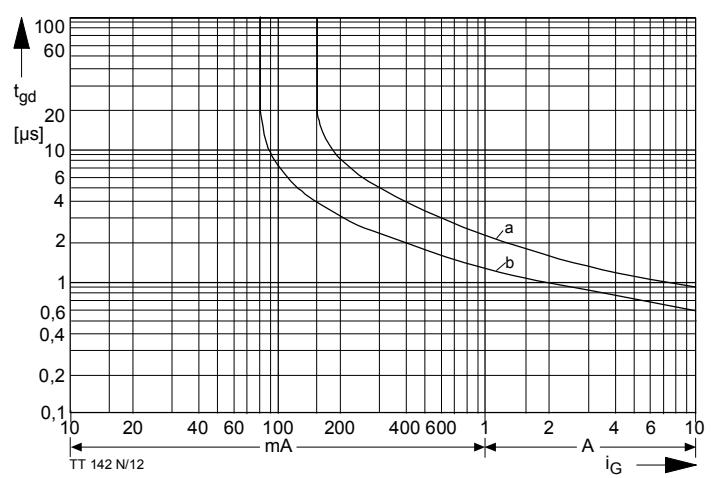


Bild / Fig. 12
Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$
 $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $di_G/dt = i_{\text{GM}}/1\mu\text{s}$
a - äußerster Verlauf / limiting characteristic
b - typischer Verlauf / typical characteristic

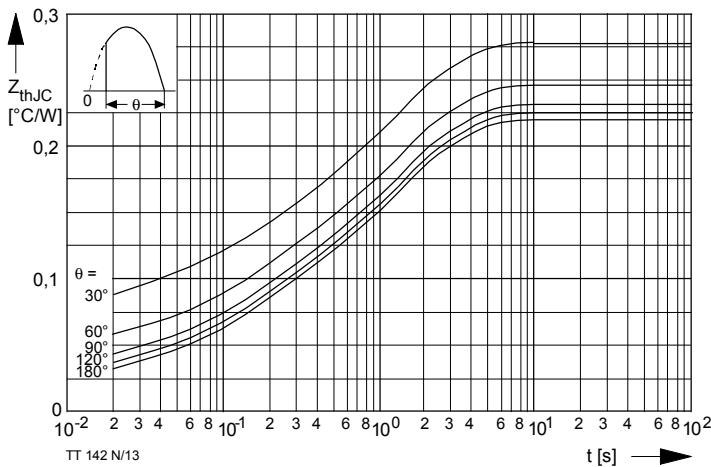


Bild / Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

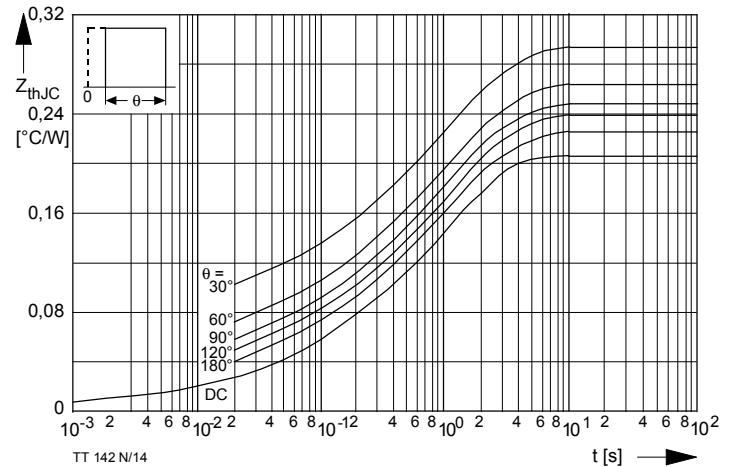


Bild / Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C}/\text{W}]$	0,0094	0,0224	0,0586	0,122			
$\tau_n [\text{s}]$	0,0014	0,0253	0,267	1,68			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$